

ICS 29.045
H 80



GB/T 1551—2009

中华人民共和国国家标准

GB/T 1551—2009
代替 GB/T 1551—1995、GB/T 1552—1995

硅单晶电阻率测定方法

Test method for measuring resistivity of monocrystal silicon

中华人民共和国
国家标准
硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1551—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1.5 字数 35 千字

2010 年 1 月第一版 2010 年 1 月第一次印刷

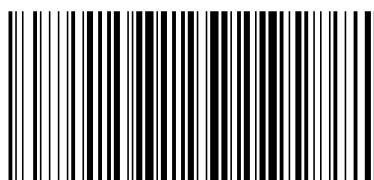
*

书号：155066·1-39551 定价 24.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 1551-2009

2009-10-30 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准修改采用 SEMI MF 84-1105《硅片电阻率测定四探针法》和 SEMI MF 397-1106《硅棒电阻率测定两探针法》。

本标准与 SEMI MF 84-1105 和 SEMI MF 397-1106 相比,主要变化如下:

——中厚度修正系数 F(W/S)表格范围增加;

——按中文格式分直排四探针法、直流两探针法进行编排。

本标准代替 GB/T 1551—1995《硅、锗单晶电阻率测定直流两探针法》和 GB/T 1552—1995《硅、锗单晶电阻率测定直排四探针法》。

本标准与 GB/T 1551—1995 和 GB/T 1552—1995 相比,主要有如下变化:

——删除了锗单晶测定的相关内容;

——用文字描述代替了原标准 GB/T 1551—1995 和 GB/T 1552—1995 中的若干记录测试数据的表格;

——修改了直排四探针法中计算公式;

——补充了干扰因素。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位:信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所。

本标准主要起草人:李静、何秀坤、张继荣、段曙光。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB 1552—1979、GB 1551—1979、GB 5251—1985、GB 5253—1985、GB 6615—1986;

——GB/T 1551—1995、GB/T 1552—1995。

